

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 17 年 12 月 22 日 (2005.12.22)

【公表番号】特表 2005-520356 (P2005-520356A)

【公表日】平成 17 年 7 月 7 日 (2005.7.7)

【年通号数】公開・登録公報 2005-026

【出願番号】特願 2004-527542 (P2004-527542)

【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 L 21/28

H 0 1 L 21/336

H 0 1 L 29/786

H 0 1 L 33/00

H 0 1 L 51/00

【F I】

H 0 1 L 21/28 3 0 1 B

H 0 1 L 21/28 B

H 0 1 L 33/00 E

H 0 1 L 29/28 Z N M

H 0 1 L 29/78 6 1 8 B

H 0 1 L 29/78 6 1 6 K

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 7 月 9 日 (2004.7.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

有機半導体デバイスの金属材料と有機材料との間に低抵抗の接触部を形成する方法であって、以下の工程：

前記有機半導体デバイスを、60 より高くかつ前記金属材料と前記有機半導体デバイスの前記有機材料との間に低抵抗の接触部を形成するのに十分な温度にさらす工程、及び前記有機半導体デバイスを冷却する工程

を含む、前記方法。

【請求項 2】

高性能絶縁ゲート型電界効果トランジスタを製造する方法であって、以下の工程：

基板、前記基板上に形成された有機半導体、前記有機半導体上に形成された絶縁体、前記有機半導体上に形成されたソース、前記絶縁体上に形成されたゲート、及び前記有機半導体上に形成されたドレインを含む絶縁ゲート型電界効果トランジスタを準備する工程、及び

前記ソースと前記有機半導体との間にオーム接触を生成するのに十分なエネルギーに前記ソースをさらす工程

を含む、前記製造方法。